

## ★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 原 直紀 副委員長 前澤宏一  
幹事 上田哲三・葛西誠也 幹事補佐 松永高治・鈴木寿一

## ★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 高野 泰 副委員長 野毛 悟  
幹事 圓佛晃次・佐藤知正 幹事補佐 小館淳一・岩田展幸

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 奈良安雄 副委員長 大野裕三  
幹事 笹子佳孝 幹事補佐 黒田理人

日時 5月28日(水) 10:30~17:10  
29日(木) 9:00~16:15

会場 名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 3階 (JR 名古屋駅から名古屋市営地下鉄:名古屋大学下車。  
<http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/facilities.html>)

議題 結晶成長, 評価及びデバイス (化合物, Si, SiGe, 電子・光材料) 及びその他

### 28日午前

1. GaInN/GaN ヘテロ接合における緩和過程の転位密度依存性  
○石原耕史・近藤保成・松原大幸・岩谷素顕・上山 智・竹内哲也 (名城大)・赤崎 勇 (名城大/名大)
2. GaN 自立基板の表面におけるサーマルクリーニングの効果  
○岡田俊祐・三宅秀人・平松和政 (三重大)・宮川鈴衣奈・江龍 修 (名工大)・橋詰 保 (北大)
3. GaNSb の Sb 取り込みと表面形態に関する検討  
○小森大資・笹島浩希・鈴木智行・竹内哲也・上山 智・岩谷素顕 (名城大)・赤崎 勇 (名城大/名大)

### 28日午後

4. 空気中で熱処理した TiN 粉末の光触媒特性の評価 ○以西雅章・山田良隆 (静岡大)・星 陽一 (東京工芸大)
5. 酸化チタンナノ構造の作製と色素増感太陽電池光電極への応用  
○岸 直希・野崎雅之・榊原将太・都築拓也・藤満新太・曾我哲夫 (名工大)
6. All Carbon P-I-N Solar Cell by MW SWP CVD  
○Dilip Chandra Ghimire・S. Adhikari・S. Ichimura・H. Uchida・K. Wakita・M. Umeno (Chubu Univ.)
7. LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 薄膜の生成条件の最適化 ○早川由洋・以西雅章 (静岡大)
8. 積層界面数が異なる強磁性-強誘電複合体の電気磁気効果 ○岩水大樹・籠宮 功・柿本健一 (名工大)
9. パルスレーザー堆積法にて SrTiO<sub>3</sub>(100) 基板上に作製した BiFe<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>O<sub>3</sub> 薄膜の結晶構造と電磁気的磁気的特性  
稲葉隆哲・○岩田展幸・渡部雄太・大島佳祐・高瀬浩一・橋本拓也・山本 寛 (日大)
10. 超高密度ターゲットを用いたパルスレーザー堆積法による Fe 系及び Mn 系ペロブスカイト型酸化物薄膜の作製  
大島佳祐・○岩田展幸・渡部雄太・稲葉隆哲・高瀬浩一・橋本拓也・山本 寛 (日大)
11. 磁気抵抗メモリにおける電子散乱過程の第一原理シミュレーション  
○洗平昌晃 (名大)・山本貴博 (東京理科大)・白石賢二 (名大)
12. 表面プラズモンによる導波路付き MOSFET の交流動作  
○酒井宏基・相原卓磨・武田愛弓・福原誠史・太田 雅・木村 優・石井佑弥・福田光男 (豊橋技科大)
13. 表面波プラズマを用いたシリコン窒化膜の化学気相堆積とデバイス応用  
○川上恭平・石丸貴博・篠原正俊・岡田 浩 (豊橋技科大)・古川雅一 (アリエスリサーチ)・若原昭浩・関口寛人 (豊橋技科大)
14. 蒸気圧制御温度差液相成長法による GaSe 結晶の電気特性と差周波 THz 発生特性  
○鈴木康平・長井悠輝・前田健作・小山 裕 (東北大)

### 29日午前

1. 窒化物系 LED 作製のレーザー加工による光取り出し効率向上の検討  
○花井 駿 (名城大)・鈴木敦志・北野 司 (ELSEED)・飯田大輔・加藤貴久・竹内哲也・岩谷素顕・上山 智・赤崎 勇 (名城大)
2. 酸素分光計測用 760 nm 分布帰還形半導体レーザーの開発  
○北島秀訓・樋口 彰・藤原淳志・内藤秀幸・前田純也 (浜松ホトニクス)
3. 窒化物半導体 LED におけるキャリア輸送への分極固定電荷の影響  
○勝野翔太・林 健人・安田俊輝・竹内哲也・岩谷素顕・上山 智・赤崎 勇 (名城大)・天野 浩 (名大)
4. 窒化物半導体 HFET 型紫外受光素子の火災センサー応用

- 山本雄磨・村瀬卓弥・石黒真未・山田知明・岩谷素顕・上山 智・竹内哲也(名城大)・赤崎 勇(名城大/名大)
5. 超狭帯域 LED 光源の開発とその皮膚医学応用 ○小笠原正弘 (ミニオンベル)・平尾 孝・藤田静雄 (京大)
6. 絶縁ゲート GaAs ナノワイヤ FET のヒステリシス特性の評価と解析  
○黒田亮太・殷 翔・佐藤将来・葛西誠也 (北大)
7. AlN 基板の表面処理とホモエピタキシャル成長  
○渡邊祥順・三宅秀人・平松和政 (三重大)・岩崎洋介・永田俊郎 (JFE ミネラル)
8. SiC 溶液成長における貫通転位変換現象と高品質化 ○原田俊太・山本祐治・宇治原 徹 (名大)

29 日午後 (13:20~)

9. 異なる Al 濃度を有する p 型 4H-SiC エピ膜の価電子帯近傍の深い準位  
○中根浩貴・加藤正史・市村正也 (名工大)
10. 高水準注入状態の SiC からの反射マイクロ波信号—キャリアライフタイムの正確な評価に向けて—  
○加藤正史・森 祐人・市村正也 (名工大)
11. P-GaN by Mg Ion Implantation for Power Device Applications  
○Zheng Sun (Nagoya Univ.)・Tetsuya Watanabe (Nissin Electric)・Tutomu Nagayama (Nissin Ion Equipment)・Yoshio Honda (Nagoya Univ.)・Hiroshi Amano (Nagoya Univ.)
12. n 型 Ge 単結晶中における Sn と空孔関連欠陥との相互作用  
○竹内和歌奈・田岡紀之・坂下満男・中塚 理・財満鎮明 (名大)
13. 光化学堆積酸化スズ薄膜 (SnO<sub>2</sub>) の光応答性 ○朴木貴法・市村正也 (名工大)
14. 溶液成長法による SnS 薄膜堆積 山中雄貴・○高野 泰 (静岡大)
15. 光照射電気化学堆積法による SnS 薄膜の作製と CdS/SnS ヘテロ接合太陽電池への応用  
○田中良和・市村正也 (名工大)
16. デバイス応用に向けたコランダム構造酸化物半導体の電気特性評価  
○金子健太郎・鈴木規央・李 三東・北島雅士・赤岩和明・藤田静雄 (京大)

☆CPM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

6 月 20 日 (金) 機械振興会館 [締切済] テーマ: 材料デバイスサマーミーティング

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

6 月 19 日 (木) 名大ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー [締切済] テーマ: MOS デバイス・メモリ高性能化—  
材料・プロセス技術 (応用物理学会; シリコンテクノロジー分科会合同開催)

8 月 4 日 (月), 5 日 (火) 北大情報教育館 [6 月 9 日 (月)] テーマ: 低電圧/低消費電力技術, 新デバイス・回路  
とその応用 (仮)